Поляронное состояние кристалла

© Ю.А. Фирсов, Е.К. Кудинов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия E-mail: kudinov@ekk.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 31 июля 2000 г.)

Рассматривается квантовая механика электрон-ядерной системы при сильной связи электронов с решеткой. Вначале в адиабатическом приближении рассмотрена двухузельная модель. С ростом константы связи электронный перенос испытывает качественные изменения: у адиабатического потенциала образуется потенциальный барьер, перенос электрона связан с туннелированием ядер через барьер, а расщепление энергетических уровней системы экспоненциально убывает.

Обсуждаются свойства аналогичной модели кристалла. Утверждается, что и в кристалле электронный перенос при сильной связи связан с туннелированием ядер в пространстве деформаций. Сильная связь модифицирует члены электрон-электронного взаимодействия. Члены гамильтониана, не связанные с переносом электрона (обменные), модифицируются слабо. Члены же, в которых перенос имеет место (зонный член), испытывают экспоненциальную редукцию и в пределе $M \to \infty$ (M — масса иона) обращаются в нуль, а носители тока являются поляронами малого радиуса. Эта редукция обеспечивает естественный механизм усиления изотопического эффекта.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 99-02-1833).

В последние годы резко возрос интерес к явлениям, связанным с сильным взаимодействием электронов с колебаниями решетки (поляронный эффект). Это было вызвано обнаружением в ряде манганатов колоссального магнетосопротивления (многообещающего в области приложений), что стимулировало многочисленные исследования их свойств (структурных, магнитных, оптических, кинетических и др. [1-5]). Одним из главных результатов этих исследований следует признать выявление существенной роли электрон-колебательного взаимодействия (ЭКВ), в частности поляронных эффектов, при интерпретации экспериментальных результатов. Отметим обнаружение в этих соединениях гигантского изотопического эффекта [6]. В работе [7] обнаружено, что при замещении О¹⁶ изотопом О¹⁸ некоторые манганаты-изоляторы переходили в проводящее состояние, т.е. изотопное замещение изменяло природу основного состояния. Вряд ли такой эффект был бы возможен в отсутствие механизма усиления изотопического эффекта, который вполне естественно реализуется в условиях сильного ЭКВ.

Несколько ранее внимание к поляронам привлекло открытие высокотемпературной сверхпроводимости, где биполяронная модель [8] рассматривается в качестве одного из конкурентов, претендующих на объяснение механизма явления. Безотносительно к успеху (или неуспеху) в этой области, заметим, что вполне оправдан и самостоятельный интерес к этой модели, как альтернативе по отношению к модели БКШ. Ее изучение может выявить ряд характеристик сверхпроводящего состояния, которые модель БКШ оставляет в тени.

В настоящей работе в рамках адиабатического приближения исследуется поведение электрона, взаимодействующего с колебаниями решетки в зависимости от константы этого взаимодействия. Рассмотрена простейшая одноэлектронная двухузельная модель (пара катионанионных комплексов), допускающая детальное изучение ее свойств.¹ На ее базе обсуждается, как эти свойства проявляются в кристалле. Отмечается, что при достаточно сильном ЭКВ ряд характеристик кристалла претерпевает качественные изменения. В частности, существенной модификации подвергаются члены гамильтониана, описывающие электрон-электронное взаимодействие.

1. Адиабатические потенциалы двухузельной модели

1) Гамильтониан рассматриваемой двухузельной модели имеет вид

$$H = H_0 + V, \quad H_0 = T + U(x_1, x_2), \quad T = \frac{1}{2m}(\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2),$$

$$U = \frac{M\omega^2(x_1^2 + x_2^2)}{2} - \sqrt{2}g(\hat{n}_1x_1 + \hat{n}_2x_2),$$

$$V = -J(\hat{a}_1^+\hat{a}_2 + \hat{a}_2^+\hat{a}_1), \quad \hat{n}_i \equiv \hat{a}_i^+\hat{a}_i, \quad (1)$$

 $\hat{p}_i = i\hbar d/dx_i$ — оператор импульса ядра *i*, \hat{a}_i^+ , \hat{a}_i — операторы рождения и уничтожения электрона на узле *i*, *i* = 1, 2, *M*, ω — масса и частота колебаний ядер, x_i — ядерная координата, *g* — константа ЭКВ, *J* — энергетическая константа, зависящая от перекрытия электронных волновых функций на разных узлах и определяющая расщепление электронных уровней при

¹ Целесообразность подобного исследования была отмечена нами в работе [9]. Заметим, что данная модель в рамках адиабатического приближения была предметом исследования многочисленных работ. Мы, однако, сочли разумным дать достаточно полное изложение, акцентируя существенные для задачи о кристалле черты.



Рис. 1. Двухузельная модель. Черные кружки — анионы, светлые — катионы.

g = 0. Гамильтониан (1) инвариантен относительно перестановки индексов (1, 2) \rightarrow (2, 1) одновременно у электронных и ядерных операторов (см. [9]). Здесь мы ограничимся рассмотрением только одноэлектронных состояний, поэтому справедливо соотношение

$$\hat{n}_1 + \hat{n}_2 = 1. \tag{2}$$

Возможная реализация этой модели представлена на рис. 1. Это два тождественных катион-анионных комплекса. Комплекс представляет собой четыре аниона, расположенные в вершинах ромба, в центре которого находится катион. Электрон мигрирует между катионами. Предполагается, что при деформации изменяется только длина диагонали ромба. Деформация характеризуется положением x_i , (i = 1, 2) одной из вершин. За нуль отсчета выбрано положение равновесия в отсутствие электрона.

В одноэлектронной задаче для данной модели ЭКВ зависит только от разности $x_1 - x_2$. Ранее, в [9], мы исследовали лишь двухузельную модель, поэтому члены, зависящие от $x_1 + x_2$, были опущены. Имея в виду рассмотрение более общей модели, мы решили до определенного момента сохранить обе переменные x_1 , x_2 . (Все параметры гамильтониана (1) совпадают с введенными в работе [9], однако выражения для энергии сдвинуты на величину $-g^2/2M\omega^2$).

2) Ищем волновую функцию стационарного состояния гамильтониана (1) в виде

$$\Psi = C_1(x_1, x_2)a_1^+|0\rangle + C_2(x_1, x_2)a_2^+|0\rangle.$$
(3)

Величины $C_i(x_1, x_2)$ удовлетворяют такой системе уравнений:

$$H_{1}(x_{1}, x_{2})C_{1} + JC_{2} = EC_{1},$$

$$JC_{1} + H_{2}(x_{1}, x_{2})C_{2} = EC_{2},$$

$$H_{i}(x) \equiv T + \frac{M\omega^{2}(x_{1}^{2} + x_{2}^{2})}{2} - \sqrt{2}gx_{i}.$$
 (4)

Адиабатические потенциалы $E_{\pm}(x_1, x_2)$ определяем, опуская в (4) члены кинетической энергии,

$$\left(\frac{M\omega^2(x_1^2+x_2^2)}{2} - \sqrt{2}gx_1 - E\right)C_1 + JC_2 = 0,$$
$$JC_1 + \left(\frac{M\omega^2(x_1^2+x_2^2)}{2} - \sqrt{2}gx_2 - E\right)C_1 = 0 \quad (5)$$

и приравнивая нулю детерминант системы (5)

$$\Delta \equiv \bar{E}^2 + \bar{E}\sqrt{2}g(x_1 + x_2) + 2g^2x_1x_2 - J^2 = 0, \qquad (6)$$
$$\bar{E} = E - \frac{M\omega^2(x_1^2 + x_2^2)}{2}.$$

Коэффициенты уравнения (6) являются симметричными функциями x_1 , x_2 , поэтому и адиабатические потенциалы E_{\pm} будут симметричными функциями x_1 , x_2 .

Особым является случай J = 0, где реализуются два несимметричных терма:

$$E_{1} = \frac{M\omega^{2}(x_{1}^{2} + x_{2}^{2})}{2} - \sqrt{2}gx_{1},$$

$$E_{2} = \frac{M\omega^{2}(x_{1}^{2} + x_{2}^{2})}{2} - \sqrt{2}gx_{2}.$$
(7)

При $E_1(x_1) \ge -E_p$ они пересекаются на линии $x_1 = x_2$, где $E_1 = E_2 = M\omega^2 x_1^2 - \sqrt{2}gx_1$. Знаку равенства соответствует $x_c = \sqrt{2}g/M\omega^2$. Сколь угодно малое конечное J симметризует потенциал в результате расхождения термов на $\pm |J|$ в точке x_c .

Введем переменные $z_i = x_i/x_0$, $x_0 = g/M\omega^2$ и обозначения²

$$E_p = \frac{g^2}{2M\omega^2} = \frac{M\omega^2 x_0^2}{2}, \quad \eta = \frac{1}{2E_p}.$$
 (8)

² Безразмерный параметр η не зависит от массы иона и является важнейшей характеристикой адиабатического потенциала. Он совпадает с введенным (из других соображений) Холстейном [10] параметром η_1 , определяющим границу между большим $\eta_1 > 1$ и малым $\eta_1 < 1$ поляроном. (Заметим, что величина E_p в (8) равна половине поляронного сдвига, введенного в [10]).



Рис. 2. Адиабатические термы двухузельной модели $\varepsilon_{\pm}(z) \equiv E_{\pm}(z)/E_p \pm z_c$ — точки поворота для низшего энергетического уровня $\hbar \omega/2$. Область между ними классически недоступна.

Имеем для адиабатических термов $E_{\pm}(x_1, x_2)$

$$E_{\pm}(x_1, x_2) = E_p \left(z_1^2 + z_2^2 - \sqrt{2}(z_1 + z_2) \right)$$
$$\pm 2\sqrt{\left(\frac{z_1 - z_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + \eta^2} \equiv E_p \varepsilon_{\pm}(z_1, z_2) \quad (9)$$

(рис. 2). (Заметим, что $\varepsilon_{\pm}(z_1, z_2)$ являются аналитическими функциями $z_{1,2}$, так как точки ветвления (9) при вещественных $J \neq 0$ лежат вне вещественной оси. Исключением является J = 0, где имеет место разрыв производных). Для $C_1(z_1, z_2)$, $C_2(z_1, z_2)$ получаем

$$C_{1}(z_{1}, z_{2}) = \pm \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 \mp \frac{(z_{1} - z_{2})/\sqrt{2}}{\sqrt{((z_{1} - z_{2})/\sqrt{2})^{2} + \eta^{2}}} \right)},$$

$$C_{2}(z_{1}, z_{2}) = \frac{J}{|J|} \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 \pm \frac{(z_{1} - z_{2})/\sqrt{2}}{\sqrt{((z_{1} - z_{2})/\sqrt{2})^{2} + \eta^{2}}} \right)}.$$
(10)

Экстремумы адиабатических термов определяются соотношениями

$$\frac{\partial \varepsilon_{\pm}(z_1, z_2)}{\partial z_1} = 2z_1 - \sqrt{2} \pm \sqrt{2} \frac{(z_1 - z_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{((z_1 - z_2)/\sqrt{2})^2 + \eta^2}} = 0,$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{\pm}(z_1, z_2)}{\partial z_2} = 2z_2 - \sqrt{2} \mp \sqrt{2} \frac{(z_1 - z_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{\left((z_1 - z_2)/\sqrt{2}\right)^2 + \eta^2}} = 0,$$

4 Физика твердого тела, 2001, том 43, вып. 3

откуда следует

$$z_1 + z_2 = \sqrt{2} \qquad (a),$$

$$(z_1-z_2)\left(1\pm \frac{1}{\sqrt{((z_1-z_2)/\sqrt{2})^2+\eta^2}}\right)=0$$
 (b). (11)

Терм E_+ имеет в пространстве (z_1, z_2) единственный минимум $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$. Терм E_- также имеет минимум в точке $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, если $\eta^2 > 1$. При $\eta^2 < 1$ точка $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ становится максимумом и появляются два минимума:

$$\begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{1-\eta^2}}{\sqrt{2}}, \frac{1-\sqrt{1-\eta^2}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$
 (a),
$$\begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{1-\eta^2}}{\sqrt{2}}, \frac{1+\sqrt{1-\eta^2}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$
 (b).

Итак, в отсутствие ЭКВ (g = 0) поверхности адиабатических потенциалов $E_{\pm}(x_1, x_2)$ являются смещенными по вертикальной оси на ±J параболоидами вращения с минимумами в точке (0,0). Включение ЭКВ приводит к понижению симметрии (до отражения в плоскости $x_1 = x_2$ и поворота на π вокруг вертикали $x_1 = x_0/\sqrt{2}$, $x_2 = x_0\sqrt{2}$) и смещению минимумов в точку ($x_0/\sqrt{2}$, $x_0/\sqrt{2}$). Превышение величиной g порогового значения g_c (см. Приложение 1), соответствующего значению $\eta = 1$, сопровождается качественным изменением нижнего терма E_{-} , именно экстремум в точке $(x_0/\sqrt{2},$ $x_0/\sqrt{2}$) расщепляется на три: максимум в точке $(x_0/\sqrt{2},$ $x_0/\sqrt{2}$) и два минимума равной глубины. Адиабатическое перемещение деформации из одного минимума в другой сопровождается переносом электрона между узлами и связано с преодолением энергетического барьера в пространстве (x_1, x_2) .

3) Далее целесообразно перейти к таким переменным:

$$X = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}, \qquad x = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}.$$
 (12)

В них гамильтониан (1) примет вид

$$H = H_0 + V, \quad H_0 = T + U_1(X) + U_2(x),$$
$$T = \frac{1}{2m} (\hat{P}^2 + \hat{p}^2),$$
$$U_1(X) = \frac{M\omega^2 (X - x_0)^2}{2} - E_p,$$
$$U_2(x) = \frac{M\omega^2 x^2}{2} - g(\hat{n}_1 - \hat{n}_2)x, \quad (1a)$$

 \hat{P} , \hat{p} — соответствующие операторы импульса.³ Зависящие от X члены (1а) не зацепляются с электронными

³ Модель, описываемая гамильтонианом (1a), использовалась в классических работах Холстейна [10,11], а также для рассмотрения задачи межзонного поглощения света малым поляроном в [12].

переменными, поэтому при рассмотрении электронной системы достаточно удержать в гамильтониане лишь член $U_2(x)$, а волновую функцию искать в виде

$$\Psi = (C_1(x)a_1^+ + C_2(x)a_2^+)|0\rangle.$$
(3a)

Система (4) принимает вид

$$H_{-}(x)C_{1} + JC_{2} = EC_{1},$$

 $JC_{1} + H_{+}(x)C_{2} = EC_{2}.$ (4a)

В (4) обозначено

$$H_{\mp}(x) \equiv \frac{\hat{p}^2}{2M} + \frac{M\omega^2 x^2}{2} \mp gx.$$

Из (9) получаем выражение для адиабатических термов $(z \equiv x/x_0)$

$$E_{\pm}(z) = E_p(z^2 \pm 2\sqrt{z^2 + \eta^2}) \equiv E_p \varepsilon(z), \qquad (9a)$$

а из (10) — для коэффициентов C_1, C_2

$$C_{1} = \pm \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 \mp \frac{z}{\sqrt{z^{2} + \eta^{2}}} \right)},$$

$$C_{2} = \frac{J}{|J|} \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 \pm \frac{z}{\sqrt{z^{2} + \eta^{2}}} \right)}.$$
(10a)

Находим первую и вторую производные $E_{\pm}(z)$ по z для определения экстремумов и перенормировки частоты

$$\frac{1}{E_p}\frac{dE_{\pm}}{dz} = 2z\left(1\pm\frac{1}{\sqrt{z^2+\eta^2}}\right),\tag{13}$$

$$\frac{1}{E_p} \frac{d^2 E_{\pm}}{dz^2} = 2 \left(1 \pm \frac{\eta^2}{(z^2 + \eta^2)^{3/2}} \right).$$
(14)

Точками экстремумов адиабатических термов $E_{\pm}(z)$ являются z = 0 и

$$z = \pm z_c, \quad z_c = \pm \sqrt{1 - \eta^2}, \quad \eta < 1.$$
 (15)

Заметим, что $E_{\pm}|_{z=0} = \pm J$. Верхний адиабатический терм $E_{+}(z)$ имеет единственный экстремум — минимум в точке z = 0. Нижний — $E_{-}(z)$ при $\eta > 1$ имеет единственный минимум при z = 0, а при $\eta < 1$ имеет максимум при z = 0 и два минимума при $z = \pm z_c$, таким образом, при $\eta < 1$ имеется потенциальный барьер (рис. 2). Значения энергии в минимумах (15)

$$\left. \frac{E_{-}(z)}{E_{p}} \right|_{z=\pm z_{c}} = -1 - \eta^{2}.$$
(16)

Высота барьера равна разности $E_{-}(0)$ и $E_{-}(z_{c})$,

$$E_b = E_p (1 - \eta)^2.$$
(17)

Перенормировка частоты определяется скобкой в (14) при $z = z_c$,

$$\omega^2 = (1 \pm \eta^2)\omega^2 \tag{18}$$

(колебание "—" смягчается, а "+" ужесточается). При $z = 0 \ \tilde{\omega}^2 = (1 \pm \eta^{-1})\omega^2$. Отметим, что в (5)–(16) масса иона содержится лишь в виде комбинации $M\omega^2$, которая имеет смысл упругой константы и от M в действительности не зависит. Зависимость от M возникает при решении уравнения Шредингера с потенциальной энергией $E_{\pm}(x)$.

2. Колебания ядер

Учтем теперь член кинетической энергии ядер. Из (5) видно, что $C_1(x_1, x_2)$, $C_2(x_1, x_2)$ определены с точностью до множителя $\chi(x_1, x_2)$. Поэтому решение $\tilde{C}_1(x)$, $\tilde{C}_2(x)$ системы (4a) можно искать в виде

$$\tilde{C}_1(x) = \chi(x)C_1(x), \quad \tilde{C}_2(x) = \chi(x)C_2(x),$$
 (19)

т.е. электронно-колебательная волновая функция равна выражению

$$\Psi = \chi(x)(C_1(x)a_1^+ + C_2(x)a_2^+)|0\rangle, \qquad (20)$$

где $C_1(x)$, $C_2(x)$ определены соотношением (10а). Заметим, что при $z = z_c$

$$C_{1}(z_{c}) = \pm \sqrt{\frac{1 \mp \sqrt{1 - \eta^{2}}}{2}},$$
$$C_{2}(z_{c}) = \frac{J}{|J|} \sqrt{\frac{1 \pm \sqrt{1 - \eta^{2}}}{2}},$$
(21)

при z = 0

$$C_1(0) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad C_2(0) = \frac{J}{|J|} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$
 (22)

Нетрудно получить

$$T(\chi(x)C_1(x)) + E_{\pm}(x)\chi(x)C_1(x) = E\chi(x)C_1(x),$$

$$T(\chi(x)C_2(x)) + E_{\pm}(x)\chi(x)C_2(x) = E\chi(x)C_2(x).$$
 (23)

T(x) есть оператор кинетической энергии колебательной системы,

$$T(x) = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} = -E_p \left(\frac{\hbar\omega}{2E_p}\right)^2 \frac{d^2}{dz^2}.$$
 (24)

Учет кинетической энергии приводит к появлению в задаче второго (помимо η) безразмерного параметра

$$\nu = J/\hbar\omega. \tag{25}$$

Его принято называть параметром адиабатичности, поскольку условием применимости адиабатического приближения является $\nu \gg 1$. Элементарная оценка показывает, что $\nu \sim (M/m^*)^{1/2} = \varkappa^{-2}$, где \varkappa — фундаментальный параметр приближения Борна–Оппенгеймера [13]. Подчеркнем, что он не зависит от константы *g* ЭКВ. Из (23) следует, что функция $\chi(x)$ должна удовлетворять двум различным уравнениям, что, вообще говоря, невозможно. Это свидетельствует о том, что понятие адиабатического потенциала применимо лишь при определенных условиях, налагаемых на параметры задачи.⁴ Действительно, в рассматриваемой задаче имеются два параметра размерности длины: $x_0 = g/M\omega^2$, который определяется видом потенциальной энергии и не зависит от массы ядра, и $l_n = \sqrt{n\hbar/2M\omega} \propto \sqrt{M}$ — осцилляторная длина, определяющая радиус *n*-го состояния осциллятора. Отношение $(l_n/x_0)^2$ равно

$$\frac{l_n^2}{x_0^2} = \frac{n\hbar\omega}{4E_p}.$$
(26)

Если это отношение мало, а параметр η не слишком мал, то для низких уровней в (23) можно пренебречь действием оператора кинетической энергии на функции $C_i(x)$ и записать первые члены в (23) как $C_i(x)T\chi(x)$. Уравнения (23) сведутся к одному

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2\chi}{dx^2} + E_{\pm}(x)\chi = E\chi.$$
 (27)

В случае $\eta < 1$ потенциал $E_{-}(x)$ представляет собой две потенциальные ямы, разделенные барьером. Если формально устремить высоту барьера к бесконечности (устремляя *J* и E_p к бесконечности при фиксированном отношении $J/E_p = 2\eta$), можно утверждать, что в стационарном состоянии ядерная волновая функция будет локализована в одной из ям, при этом ее амплитуда в другой яме равна нулю. Каждый уровень энергии будет дважды вырожден, волновые функции можно записать как $\chi(x - x_0 z_c)$, $\chi(x + x_0 z_c)$, их перекрытие равно нулю. Полные электронно-ядерные функции дублета есть

$$\Psi_{1,2} = \chi(x \mp x_0 z_c) \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(-\sqrt{1 \pm \sqrt{1 - \eta^2} a_1^+} + \frac{J}{|J|} \sqrt{1 \mp \sqrt{1 - \eta^2} a_2^+} \right) |0\rangle.$$
(28)

١

Ввиду резкого убывания функций χ в правой части мы заменили $C_i(x)$ на их значения при x, соответствующих точкам минимума адиабатического потенциала E_- . Очевидно, что матричный элемент любого оператора между состояниями Ψ_1 и Ψ_2 равен нулю. Поэтому и вероятность перескока электрона между узлами обращается в нуль. Заметим, что в состояниях (28) имеется корреляция между состоянием колебательной системы и распределением электронного заряда между узлами. Например, в состоянии Ψ_1 доли заряда на узлах 1 и 2 равны соответственно $(1 + \sqrt{1 - \eta^2})/2$ и $(1 - \sqrt{1 - \eta^2}/2)$, при этом деформация локализована в окрестности узла 1 (рис. 1). Отметим также, что учет ЭКВ в адиабатическом приближении приводит к распространению электронной плотности на соседний узел 2 с весом $(1 - \sqrt{1 - \eta^2})^2/4$.

Если высота барьера конечна, функции $\chi(x \mp x_0 z_c)$ перекрываются и появляется возможность межузельного перескока электрона, что приведет к расщеплению дублета (28). Будем называть рассмотренную ситуацию $\eta < 1$ случаем сильной связи (имея в виду сильную электрон-колебательную связь).

При $\eta > 1$ барьер исчезает и термы E_{\pm} имеют единственный экстремум — минимум при $z_c = 0$. Учитывая (22), волновую функцию можно записать как

$$\Psi = \chi(x) \frac{1}{\sqrt{2}} \left(a_1^+ \pm a_2^+ \right) |0\rangle.$$
(29)

Ввиду того что оба электронных состояния входят с равным весом, упомянутая выше корреляция отсутствует, как и в случае пренебрежения ЭКВ. Роль последнего проявляется в возникновении непараболичности адиабатических потенциалов и поправок к электронной волновой функции. При $\eta \gg 1$ волновые функции и энергии низкоэнергетических состояний близки к соответствующим величинам системы в отсутствие ЭКВ (случай слабой связи)

$$\Psi_{n\pm}^{(0)}(x) = \psi_n^{(0)}(x) \frac{1}{\sqrt{2}} (a_1^+ \pm a_2^+) |0\rangle,$$
$$E_{n\pm} = \pm J + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega.$$
(30)

(Здесь $\psi_n^{(0)}(x)$ — собственные функции гармонического осциллятора). Соответствующие эффекты в принципе могут быть рассмотрены в рамках теории возмущения по электрон-колебательному взаимодействию.

Итак, в нашей системе реализуется одно из двух качественно различных состояний (28), (29) в зависимости от наличия или отсутствия энергетического барьера у низшего адиабатического терма E_{-} . Этот барьер является следствием возникновения двух минимумов у $E_{-}(x_1, x_2)$ при $\eta < 1$. Переход между этими двумя режимами происходит в окрестности $\eta = 1$, где возможно существование особенности в пространстве параметров. Аналитическое исследование области исчезновения барьера весьма затруднительно даже в рамках двухузельной задачи. (Было бы полезно провести подобное исследование численными методами, опираясь на изложенные выше соображения).

3. Расщепление уровней в адиабатическом приближении

Для нахождения расщепления уровней, возникающего вследствие наличия энергетического барьера у низшего адиабатического терма, воспользуемся квазиклассическим приближением (КП). Вообще говоря, КП применимо для сильно возбужденных уровней. Однако уровни

⁴ Чтобы удовлетворить (23), необходимо вместо (19) искать решение в виде $\tilde{C}_i(x) + \Delta C_i(x)$. Вопрос об ограниченности концепции адиабатического потенциала обсуждается в классической монографии [13], глава 4 и Приложения VII и VIII.

энергии гармонического осциллятора, определенные в КП, совпадают с их точными значениями. Поскольку адиабатические потенциалы нашей задачи в актуальной области имеют осцилляторный характер, можно полагать, что КП адекватно описывает ситуацию и в области малых квантовых чисел *n*. В случае сильной связи адиабатический потенциал $E_{-}(x)$ представляет собой две ямы, разделенные барьером (рис. 2). Решение задачи о расщеплении ΔE глубокого уровня с энергией *E* порядка $-E_p$ в КП для такого потенциала приведено в [14] (стр. 208, задача 3)

$$\Delta E = \frac{\hbar \tilde{\omega}}{\pi} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{a}^{b} p dx\right), \qquad (31)$$

$$p = \sqrt{2M|E - E_-(x)|}.$$

Ядерные волновые функции дублета равны

$$\chi_{\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1(x) \pm \varphi_2(x)),$$
 (32)

где $\varphi_i(x)$ — квазиклассическая волновая функция в *i*-й яме. Интегрирование производится между точками поворота *a*, *b*; $\tilde{\omega}$ — частота классического движения в потенциальной яме $E_{-}(x)$ с энергией *E*. (Показатель экспоненты в (31) убывает с ростом энергии возбуждения, если туннелирование совершается из возбужденного состояния).

Рассмотрим расщепление низшего уровня с квантовым числом n = 0. Энергия такого возбуждения (энергия нулевых колебаний) равна $\hbar \tilde{\omega}/2$, где $\tilde{\omega} = \omega \sqrt{1 - \eta^2}$ (что совпадает с (18)). Результат зависит от произведения параметров $\eta \nu \equiv \eta_3 = J^2/(\hbar \omega E_p)$. При $\eta_3 < 1$ можно получить

$$\Delta E = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sqrt{\hbar\omega E_p} \exp\left(-\frac{2E_p}{\hbar\omega}\right).$$
(33)

В случае $\eta_3 > 1$ (точнее, в адиабатическом пределе $M \to \infty$) можно пренебречь энергией нулевых колебаний и интегрировать от $-x_0$ до x_0 . Предэкспоненциальный множитель в (31) не меняется, а для интеграла в показателе (31) получим

$$\frac{1}{\hbar} \int_{-x_c}^{+x_c} p dx = \frac{2E_p}{\hbar\omega} f(\eta),$$

$$(\eta) = \sqrt{1 - \eta^2} - \eta^2 \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \eta^2}}{\eta}$$
(34)

Итак, в этом случае имеем⁵

f

$$\Delta E = \frac{\hbar \tilde{\omega}}{\pi} \exp\left(-\frac{2E_p}{\hbar \omega} f(\eta)\right).$$
(35)

Для оценок в ряде случаев достаточно использовать аппроксимацию

$$f(\eta) = 1 - \eta. \tag{36}$$

С учетом (32) волновые функции дублета в этом приближении выражаются через волновые функции (28)

$$\Psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_1 \pm \Psi_2). \tag{37}$$

В отличие от (28) они согласуются с симметрией гамильтониана (1) (обладают определенной четностью при замене индексов $(1,2) \rightarrow (2,1)$). Обратим внимание на аналогию структуры этих функций со структурой волновых функций приближения сильной связи (или MO LCAO в теории молекул), где волновая функция стационарного состояния строится как суперпозиция локализованных на узлах электронных функций с универсальными коэффициентами, определяемыми симметрией системы. Однако в данном случае эти локализованные "атомные" функции являются локализованными электрон-деформационными комплексами. В [9] исследовалась данная двухузельная модель в противоположном рассматриваемому выше, "антиадиабатическом" пределе *v* < 1 в рамках теории возмущения по Ј.6 В этой модели существует аналог рассматриваемого выше барьера и, следовательно, аналог расщепления нижнего дублета. Было отмечено, что величина этого расщепления J* равна

$$J^* = J \exp(-2E_p/\hbar\omega). \tag{38}$$

Сравнивая выражения для (33), (35) с результатом J^* (38) первого порядка теории возмущения по J, можно видеть, что величина ΔE всегда содержит фононную экспоненту,⁷ однако предэкспоненциальный множитель J заменяется на $(2\sqrt{2}/\pi)\sqrt{\hbar\omega E_p}$ или $\hbar\tilde{\omega}/\pi$. Итак, в адиабатической области предэкспонента J^* перестает существенно зависеть от J,⁸ но зависимость от этой величины проявляется в показателе экспоненты из-за присутствия множителя $f(\eta)$.

Заметим, что в выражении для ΔE (35) от массы иона M зависят только величины ω , $\tilde{\omega} \propto \sqrt{1/M}$. Поэтому при $M \to \infty$ в области $\eta < 1$ величина ΔE экспоненциально убывает как $\exp(-\sqrt{M})$, и в этом пределе электроны строго локализованы на узлах, а перенос

⁵ В [11] без вывода приведено полученное методом WKB выражение (116) для ΔE . С точностью до множителя порядка единицы (~ 0.87) оно совпадает с (33).

⁶ Вопрос о параметре малости остается открытым. Условие $\nu < 1$ гарантирует убывание членов разложения с ростом порядка, но не вполне реалистично, предполагая малость величины *J* (которая порядка электронной энергии E_e) по сравнению с $\hbar\omega$, которая $\sim E_e\sqrt{m/M}$ (m — масса электрона). В то же время в разложении *J* встречается и в виде $J/2E_p \equiv \eta$ — параметра, малого в условиях сильной связи. Реальным параметром разложения может оказаться величина вида $\eta^{\alpha}\nu^{1-\alpha}$ (например, $(\eta\nu)^{1/2} \equiv \eta_3^{1/2}$), и условие применимости подхода [9] окажется слабее, чем $\nu < 1$

⁷ Теория возмущения не накладывает условий на величину показателя экспоненты в (38). Однако интерес представляет лишь случай, когда он велик по модулю.

⁸ Строго говоря, предэкспонента зависит от *J* из-за появления множителя $1 \pm \eta^2$ (см. (18)), что приводит к дополнительному ее уменьшению для низшего (–) терма.

заряда между узлами отсутствует. Как показано в [9], эта экспоненциальная малость присутствует во всех членах ряда теории возмущения по J, которые ответственны за расщепление терма, т. е. ее наличие установлено вне рамок адиабатического приближения, а последнее фигурирует лишь в качестве метода суммирования указанного ряда. Члены же, ответственные за сдвиг центра тяжести дублета (поправки к поляронному сдвигу), в пределе $M \to \infty$ остаются конечными.⁹

В пределе слабой связи все члены ряда теории возмущения по ЭКВ для ΔE при $M \to \infty$ обращаются в нуль, электронные состояния делокализованы и образуют невозмущенный дублет с расщеплением 2*J*

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{a}_1^+ \pm \hat{a}_2^+) |0\rangle, \quad E_{\pm} = \pm J.$$
 (39)

Таким образом, в рассматриваемой задаче в зависимости от значений параметра η реализуются две ветви решений: слабой связи (39) при $\eta > 1$ и сильной связи (28) при $\eta < 1$. Наиболее существенным эффектом проявления сильной связи является появление экспоненциальной малости $\exp(-E_p/\hbar\omega)$, которая может уменьшить ряд характеристических параметров на несколько порядков. Экспонента в (35) также реализует механизм усиления изотопического эффекта [6].¹⁰ Именно замена ядра с массой M на ядро с массой $M + \Delta M$ приводит к умножению (35) на

$$\exp\left(-\frac{E_p}{\hbar\omega}\frac{\Delta M}{M}\right).\tag{40}$$

При вполне реальном значении параметра ЭКВ $\lambda = 10$ и $\Delta M/M = 0.1$ изотопическое замещение приведет к изменению величины J^* в *е* раз, что может радикально изменить электронные характеристики (например, перевести диэлектрик в металл). Поэтому результаты работы [7] можно понимать и как веский аргумент в пользу существования веществ, в которых реализуется упомянутая сильная связь.

Отметим, что "барьерная" экспонента, приводящая к эффективному уменьшению J^* ("барьерный эффект") и реализующая механизм усиления, возникает уже в низшем порядке по J, а последующий рост J при $\eta < 1$ лишь модифицирует ее.

4. Модель поляронного кристалла

Рассмотрим простейшую модель кристалла, состоящую из описанных выше катионанионных комплексов, а именно правильный *n*-угольник, где *n* сколь угодно велико. Гамильтониан такой модели имеет вид

$$\sum_{m=1}^{n} \left(\frac{\hat{p}_{m}^{2}}{2M} + \frac{M\omega^{2}x_{i}^{2}}{2} - \sqrt{2}g\hat{n}_{m}x_{m} \right) - \sum_{m=1}^{n-1} J(\hat{a}_{m}^{+}\hat{a}_{m+1} + \hat{a}_{m+1}^{+}\hat{a}_{m}).$$
(41)

Каноническое преобразование [16]

$$U = \prod_{m=1}^{n} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \frac{\sqrt{2g}}{M\omega^2} \hat{n}_m \hat{p}_m\right)$$
$$\equiv \prod_{m=1}^{n} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \sqrt{2x_0} \hat{n}_m \hat{p}_m\right)$$
(42)

устраняет линейные по *x_i* члены гамильтониана и преобразует электронные операторы

$$\tilde{a}_{m}^{+} = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m}\right)\hat{a}_{m}^{+},$$
$$\tilde{a}_{m} = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m}\right)\hat{a}_{m}.$$
(43)

Каноническое преобразование сохраняет соотношения коммутации, поэтому операторы \tilde{a}_m^+ , \tilde{a}_m являются Ферми-операторами. Получаем

$$\tilde{H} = \sum_{m=1}^{n} \left(\frac{\hat{p}_{m}^{2}}{2m} + \frac{M\omega^{2}x_{m}^{2}}{2} \right) - 2E_{p} \sum_{m=1}^{n} n_{m} - \sum_{m=1}^{n-1} J(\tilde{a}_{m}^{+}\tilde{a}_{m+1} + \tilde{a}_{m+1}^{+}\tilde{a}_{m}).$$
(44)

Преобразованный оператор \tilde{a}_m^+ рождает на узле *m* электрон вместе с оптимальной деформацией. Такой комплекс при $\eta < 1$ представляет собой полярон малого радиуса. При J = 0 это преобразование точно диагонализует гамильтониан и в условиях сильной связи $\eta < 1$ дает возможность построения теории возмущения по J. При J = 0 имеется *n*-кратное вырождение по номеру узла *m*. В состоянии с низшей энергией все квантовые числа осцилляторов равны 0, и энергетический спектр полярона описывается зонным членом гамильтониана с перенормированным J^* , определяемым (38) (поляронное сужение зоны). Волновая функция полярона с квазиимпульсом *k* есть

$$\psi_{k} = \sum_{m=1}^{n} e^{ikm} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m}\right) \Phi_{0}(x_{1},\dots,x_{n})a_{m}^{+}|0\rangle, \quad (45)$$
$$\Phi_{0}(x_{1},\dots,x_{n}) = \prod_{m=1}^{n} \psi_{0}^{(0)}(x_{m}).$$

Область применимости теории возмущения ограничена лишь условием $\nu < 1$.

Рассмотрим данную задачу в адиабатическом приближении. Действуя как ранее, получаем систему, определяющую коэффициенты $C_i(x_1, \ldots, x_n)$ и адиабатические

⁹ Предэкспонента зависит от M как $M^{-1/4}$ (33) либо $M^{-1/2}$ (35).

¹⁰ В применении к модели биполяронного сверхпроводника этот механизм рассматривался в [15].

потенциалы $E_i(x_1, \ldots, x_n)$:

$$U_1C_1 - JC_2 - \dots -JC_n = EC_1,$$

 $-JC_1 + U_2C_2 - JC_3 \dots = EC_2,$

$$-JC_1 \ldots \ldots - JC_{n-1} + U_nC_n = EC_n.$$

$$U_{s} = \sum_{m=1}^{n} \frac{M\omega^{2} x_{m}^{2}}{2} - \sqrt{2}gx_{s} \equiv U_{0} - \sqrt{2}gx_{s}.$$
 (46)

Нетрудно убедиться, что определитель $\Delta(E)$ этой системы не меняется при циклической перестановке индексов (1, 2, ..., n). Поэтому коэффициенты алгебраического уравнения $\Delta(E) = 0$, а следовательно, и адиабатические потенциалы $E_i(x_1, ..., x_n)$ будут функциями деформаций $x_1, ..., x_n$, инвариантными относительно этих перестановок. (При J = 0 адиабатические потенциалы $E_i = U_0 - \sqrt{2}gx_i$ не инвариантны относительно указанных преобразований, но уже при бесконечно малом J они симметризуются, см. формулу (9) двухузельной модели).

В отсутствие ЭКВ (g = 0) адиабатические потенциалы равны $E_i = U_0 + E_i^0$, $E_i^0 = \text{const.}$ Единственный экстремум (минимум) находится в точке $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$. При достаточно малых *g* происходит лишь зависящее от *i* и не нарушающее симметрию гамильтониана смещение этого минимума в точку $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = x_0^{(i)}$.

При бесконечно малом J и $g \neq 0$ низший адиабатический терм имеет n минимумов в точках ($x_m = x_0, x_{m'} = 0$, $m' \neq m, m = 1, ..., n$). Асимптотически, когда все $x_i \to \infty$, он является n-мерным параболоидом в n-мерном пространстве деформаций ($x_1, ..., x_n$). (Не следует смешивать это пространство с реальным пространством, в котором расположены узлы решетки). Низколежащие электронные состояния локализованы на комплексах. Перенос на соседний узел (|m - m'| = 1) связан с преодолением одного энергетического барьера. Его высоту при бесконечно малом J легко оценить. Глубина минимума в точке ($x_0, 0, ..., 0$) очевидно равна $2E_p$ (т. е. поляронному сдвигу). Вершине барьера соответствует минимальная энергия E_{min} на линии $x_i = x_j$, в которой энергии E_i , E_j ,

$$E_i(x_i,...,x_n) = \frac{M\omega^2(x_i-\sqrt{2}x_0)^2}{2} - 2E_p + \sum_{m \neq i} \frac{M\omega^2 x_m^2}{2}$$

двух минимумов *i* и *j* совпадают. Нетрудно видеть, что такой точкой является $x = x_0\sqrt{2}$, а $E_{\min} = -E_p$, т. е. высота барьера равна $2E_p$. (Структуру всех *n* адиабатических термов в пределе $J \to 0$ нетрудно описать аналогичным образом, но в данной работе она не используется и мы опускаем соответствующее рассмотрение).

Отметим, что перенос электрона с узла m на узел m' сопровождается последовательным преодолением |m - m'| барьеров в пространстве деформаций. В принципе энергетический спектр электронов должен определяться из уравнения Шредингера в *n*-мерном пространстве деформаций, аналогичного (27). Это сопряжено с большими математическими трудностями.

Однако заметим, что в приближении сильно связанных электронов разумно моделировать электронный гамильтониан *H*_e выражением

$$H_{\rm e} = \sum_{\{\mathbf{m},\mathbf{m}'\},\sigma} I_{\mathbf{m},\mathbf{m}'} a^+_{\mathbf{m},\sigma} a_{\mathbf{m}',\sigma}, \qquad (47)$$

где суммирование производится по узлам **m**, являющимся ближайшими соседями, а $2I_{m,m'}$ есть расщепление уровней в двухузельной задаче с парой узлов **m**, **m**'. Можно надеяться, что удовлетворительное описание рассматриваемой модели кристалла в адиабатической области $\nu > 1$ дается заменой *I* на имеющую тот же смысл величину ΔE (35). Поэтому для описания электронного переноса в адиабатической области достаточно перенормировать параметр *J*. (Заметим, что при малых η модуль показателя в барьерной экспоненте велик).

Принимая во внимание сказанное в разделе 1 и Приложении 1, можно утверждать, что описанная выше структура E_i с n минимумами возникает, когда g превышает некоторое g_c , т.е. имеет место пороговый эффект. Поскольку структура адиабатических потенциалов описывается единственным безразмерным параметром $\eta = J/2E_p$, то соответствующий критерий примет вид: $\eta < \eta_c$.

5. Электрон-электронное взаимодействие

Теперь рассмотрим, какие изменения производит сильное ЭКВ в электрон-электронном взаимодействии. Гамильтониан последнего в узельном представлении имеет вид

$$H_{ee} = \sum_{m_1, m_2, m_3, m_4} \sum_{\sigma, \sigma'} A(m_1, m_2, m_3, m_4) \\ \times \hat{a}^+_{m_1, \sigma} \hat{a}^+_{m_2, \sigma'} \hat{a}_{m_3, \sigma'} \hat{a}_{m_4, \sigma}, \qquad (48)$$

где A — числовые функции, σ — спиновый индекс. Каноническое преобразование (42) приведет к появлению под знаком суммы в (48) операторных произведений

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m_{1}}\right)\exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m_{2}}\right)$$
$$\times\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m_{3}}\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}x_{0}\hat{p}_{m_{4}}\right).$$
 (49)

Члены суммы (48), для которых выполняются соотношения

 $m_1 = m_3, \quad m_2 = m_4 \quad \text{if } m_1 = m_4, \quad m_2 = m_3, \quad (50)$

не связаны с процессами реального переноса электрона между узлами (это главные члены кулоновского взаимодействия и прямого обмена). Нетрудно видеть, что операторный множитель (49) при этих членах обращается в единицу. Поэтому на обусловленные этими членами явления (ферро-антиферромагнетизм) сильное ЭКВ существенного влияния не оказывает, барьерный эффект отсутствует и не реализуется механизм усиления изотопического эффекта. Это относится и к механизмам косвенного обмена через промежуточное состояние с образованием пары на узле, так как перенос электрона здесь является виртуальным процессом (см. Приложение 2). Ввиду эффекта сужения ширины зоны встает вопрос о модификации критерия реализации диэлектрического или проводящего состояния (подобного известному критерию Мотта) вследствие необходимости учета магнитного порядка.

Можно надеяться, что следующие приближения по J будут содержать только не зависящий от ν (т.е. от M) параметр η .

Заметим также, что сильное ЭКВ приводит к появлению отрицательной добавки $-2E_p$ к энергии хаббардовского отталкивания, которая не зависит от массы иона.

Рассмотрим члены (48), описывающие процесс реального переноса электрона. Таким, например, является член с $m_1 \neq m_2$, если ни один из этих индексов не совпадает с m_3 , m_4 . Операторное произведение (49) в них отлично от единицы. В низшем порядке по *J* при соответствующих коэффициентах *A* появляются множители $\exp(-2E_p/\hbar\omega)$ (их редукция вследствие барьерного эффекта). В частности, при члене (48) с

$$m_1 = m_2, \quad m_3 = m_4, \quad m_1 \neq m_3$$
 (51)

операторное произведение (49) равно

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}2\sqrt{2}x_0\hat{p}_{m_1}\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}2\sqrt{2}x_0\hat{p}_{m_3}\right).$$
 (52)

В низшем порядке по *J* соответствующие коэффициенты *A* перенормируются с множителем $\exp(-8E_p/\hbar\omega)$,¹¹ что гораздо значительнее редукции $\exp(-2E_p/\hbar\omega)$ ширины одноэлектронной зоны. Эта редукция реализует механизм усиления изотопического эффекта в явлениях, за которые ответственны рассматриваемые члены.

Заметим, что в кристаллах, в которых реализуется усиление изотопического эффекта, открывается возможность тонкого контроля параметров посредством изменения изотопного состава.

В пределе $M \to \infty$ электроны полностью локализованы и рассматриваемая модель переходит в модель Гайтлера—Лондона.

Проделанные оценки базируются на низшем приближении теории возмущения по J, справедливом при $\nu < 1$. Принимая во внимание достаточно очевидную барьерную природу рассматриваемых явлений в случае $\nu < 1$, можно с высокой степенью достоверности предполагать, что и в области $\nu > 1$ соответствующие величины будут пропорциональны надлежащим образом модифицированной барьерной экспоненте при условии реализации "барьерного" режима $\eta < 1$. (В работе [9] анализ ряда теории возмущения для двухузельной модели подтвердил это предположение).

Поскольку все основные параметры, фигурирующие в адиабатическом подходе, имеют локальную природу, детальное исследование механизмов конкретных явлений в адиабатической области $\nu > 1$ разумно производить на "малых" моделях, подобных рассмотренной выше двухузельной.

6. Обсуждение результатов

Нет особых сомнений в том, что в условиях слабой электрон-колебательной связи в пределе бесконечно тяжелых ядер эффект взаимодействия электрона с ядрами сводится к статическому полю, действующему на электрон. Характеристики зонного спектра (ширина зоны ΔE , эффективная масса m^* и т.п.) в этом пределе остаются конечными.

С другой стороны, наиболее примечательным следствием возникновения описанного выше энергетического барьера адиабатического потенциала для процесса "переноса" ядерного смещения с узла на узел и вызванной этим редукции эффективной ширины электронной зоны является исчезновение механизма переноса электронов в пределе $M \to \infty$, т.е. полная их локализация. В этом случае $\Delta E \rightarrow 0, m^* \rightarrow \infty$ по экспоненциальному закону. (Прямым следствием этого является усиление изотопического эффекта с ростом электрон-колебательного взаимодействия). Это значит, что между случаями слабой и сильной связи электронов с колебаниями имеется существенное качественное различие. Можно было бы думать, что такой результат является следствием адиабатического приближения, а выход за его рамки приведет к возможности переноса и в этом пределе. Однако тот факт, что в двухузельной модели экспоненциальная малость $\exp(-\sqrt{M})$ содержится во всех членах ряда теории возмущения по Ј для расщепления дублета, свидетельствует о том, что подобная ситуация не реализуется.

Барьерный эффект приводит к существенной модификации как зонного члена гамильтониана (носители тока становятся поляронами малого радиуса), так и членов взаимодействия. (Важнейшие особенности этой модификации становятся особенно наглядными после канонического преобразования (42) гамильтониана). В расчетах из первых принципов возможность его реализации следует принимать во внимание на самых первых этапах. При этом фигурирующие в модельных гамильтонианах (41), (48) константы *g*, *J*, *A* будут выражены через

¹¹ Наличие такой перенормировки отмечено в [17]. Один из авторов данной статьи (ЕКК) пользуется случаем заметить, что в [17] этот множитель ошибочно приведен с вдвое меньшим показателем (это, впрочем, не отражается на сделанных там выводах).

фундаментальные константы e, \hbar , m, M. (При анализе экспериментальных данных надо критически относиться к использованию известных полуфеномелогических оценок этих констант (константы Фрёлиха и т. п.), поскольку условия, при которых они выводились, могут не выполняться).

Выше рассматривалась главным образом область выраженного барьерного эффекта $\eta < \eta_c$, где носители тока заведомо являются поляронами малого радиуса. Поляроны большого радиуса (ПБР) могут реализоваться вне этой области при не слишком слабом ЭКВ. Во всех известных нам исследованиях задачи о ПБР использовались различные варианты прямых вариационных методов (эвристическая сила которых по самой их природе невелика) в узкой области изменения параметров. Поэтому исследования в этом направлении весьма желательны, и особый интерес вызывает исследование области промежуточного ЭКВ ($\eta \ge \eta_c$) в пределе $M \to \infty$. В принципе возможна такая, например, альтернатива.

А. Во всей области $\eta > \eta_c$ при $M \to \infty$ имеем $m^* \to m_0$ (m_0 — эффективная масса электрона при g = 0). Тогда качественного различия между слабым ЭКВ и ПБР нет.

В. В области $\eta > \eta_c \ M \to \infty$ реализуется $m^* \to \infty$, более слабое, чем экспоненциальное. (Подобный результат, например, приведен в книге [18]). С дальнейшем убыванием ЭКВ (т.е. росте η) при $\eta > \eta_1$ реализуется $m^* \to m_0$. Это можно было бы интерпретировать как образование в области $\eta_c < \eta < \eta_1$ ПБР — связанного состояния электрон+деформация. Возникновение при $\eta < 1$ барьера приводит к экспоненциальному росту m^* и превращению ПБР в полярон малого радиуса.

Последовательное аналитическое рассмотрение области промежуточной связи даже в рамках простой модели, использованной в данной работе, сопряжено с большими математическими трудностями. Последние связаны с тем, что ПБР распространяется на много узлов решетки и использование "малых" моделей, подобных двухузельной, лишается смысла. Здесь целесообразно использование численных методов исследования. Подобные исследования модели (41) в настоящее время интенсивно проводятся (см., например, [18–25]). В [21] собраны аналитические выражения для m^* , полученные рядом авторов. Имеется согласие этих выражений с численными результатами как [21], так и ряда других авторов. Они довольно хорошо согласуются с **А**.

Однако поведение зонных характеристик при $M \to \infty$ нигде не исследовалось. В свете сказанного выше представляется весьма желательным провести подобное исследование численными методами на базе точной диагонализации гамильтониана.

Авторы благодарны Ю. Раннингеру, дискуссия с которым в значительной степени стимулировала данную работу, а также А.С. Александрову, который возродил интерес авторов к поляронной теме и принял активное участие в дискуссии.

Приложение 1. Пороговый эффект

Адиабатический потенциал имеет вид $E(x_1, x_2) = (M\omega^2/2)(x_1^2 + x_2^2) + \xi(x_1, x_2)$, где $\xi(x_1, x_2)$ не имеет особенностей и стремится к 0, когда $g \to 0$. При g = 0 имеется единственный минимум $x_1 = x_2 = 0$. С ростом g появлению дополнительных экстремумов должно предшествовать "уплощение" минимума, т.е. в критической точке

$$\Delta^{(2)} \equiv \frac{\partial^2 E}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 E}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 E}{\partial x_1 \partial x_2}\right) = 0. \tag{II1.1}$$

При $g = 0 \Delta^{(2)} = (M\omega^2)^2$. При малых *g* условие (П 1.1) может быть выполнено. Дополнительные экстремумы появляются только, когда *g* превысит некоторое пороговое значение g_c . Эти соображения справедливы и в случае большого числа величин x_i .

Приложение 2. Константы косвенного взаимодействия

Поправка второго порядка к гамильтониану, определяющему расщепление вырожденного низшего уровня с энергией E_0 , имеет вид

$$\Delta H_{ij}^{(2)} = \sum_{n} \frac{\langle i0|V'|n\rangle \langle n|V'|i'0\rangle}{E_0 - E_n}, \qquad (\Pi \, 2.1)$$

где i, i' — квантовые числа этого уровня, V' — недиагональная часть возмущения. Суммируется по всем возбужденным состояниям (знаменатель всегда < 0). Пусть зонный член гамильтониана имеет вид $H_b = \sum_{\mathbf{m}, \mathbf{g}, \sigma} J(\mathbf{g}) \tilde{a}^+_{\mathbf{m}+\mathbf{g}, \sigma} \tilde{a}_{\mathbf{m}, \sigma}$. Поправка к константе обмена за счет образования виртуальной пары есть

$$\Delta I_{\text{exc}}(\mathbf{g}) = -\sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \frac{J^2(\mathbf{g})}{E_{\text{H}} + (n_1 + n_2)\hbar\omega} \\ \times \langle 0|\tilde{a}^+_{\mathbf{m}+\mathbf{g},\sigma} \tilde{a}_{\mathbf{m},\sigma} | n_{\mathbf{m}}, n_{\mathbf{m}+\mathbf{g}} \rangle \langle n_{\mathbf{m}}, n_{\mathbf{m}+\mathbf{g}} | \tilde{a}^+_{\mathbf{m},\sigma'} \tilde{a}_{\mathbf{m}+\mathbf{g},\sigma'} | 0 \rangle.$$
(II 2.2)

(Здесь $E_{\rm H} > 0$ — энергия Хаббарда; $|0\rangle$ — основное состояние невозмущенной системы колебательной системы; $|n_{\rm m}, n_{\rm m+g}\rangle$ — состояния этой системы с возбуждениями на узлах **m** и **m** + **g**). (П 2.2) можно записать так:

$$\Delta I_{\rm exc}(\mathbf{g}) = -\sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \frac{J^2}{E_{\rm H} + (n_1 + n_2)\hbar\omega} \\ \times \langle 0| \exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}g\hat{p}_{\mathbf{m}+\mathbf{g}}\right) \exp\left(\frac{-i}{\hbar}\sqrt{2}g\hat{p}_{\mathbf{m}}\right) |n_1, n_2\rangle \\ \times \langle n_1n_2| \exp\left(\frac{i}{\hbar}\sqrt{2}g\hat{p}_m\right) \exp\left(\frac{-i}{\hbar}\sqrt{2}g\hat{p}_{\mathbf{m}+\mathbf{g}}\right) |0\rangle. \quad (\Pi 2.3)$$

С помощью соотношений (32) из [9] сумма в (П 2.3) может быть представлена как

$$\Delta I_{\rm exc}(\mathbf{g}) = -\frac{J^2}{E_{\rm H}}$$

$$\times \int_0^\infty \exp\left(-z - \frac{4E_p}{\hbar\omega} (1 - \exp(-z\hbar\omega/E_{\rm H}))\right) dz. \quad (\Pi 2.4)$$

При $\hbar\omega/E_{\rm H} \rightarrow 0$ значение $\Delta I_{\rm exc}$ конечно и равно $\Delta I_{\rm exc} = -J^2$. $E_{\rm H}$, т.е., как и в члене первого порядка, барьерный эффект отсутствует.

Список литературы

- J. van den Brink, W. Stekelenburg, D.I. Khomskii, G.A. Sawatzky, K.I. Kugel. Cond-mat/9802146.
- [2] M. Quijada, J. Cerne, J.R. Simpson, H.D. Drew, K.H. Ahn, A.J. Millis, R. Shreekala, R. Ramesh, M. Rajeswari, T. Venkatesan. Cond-mat/9803201.
- [3] K.H. Kim, J.H. Jung, T.W. Noh. Cond-mat/9804167.
- [4] A.S. Alexandrov, A.M. Bratkovsky. Cond-mat/9806030.
- [5] Unjong Yu., B.I. Min. Cond-mat/9906263.
- [6] Guo-meng Zhao, K. Conder, H. Keller, K.A. Müller. Nature 381, 676 (1996).
- [7] Н.А. Бабушкина, Л.М. Белова, В.И. Ожогин, О.Ю. Горбенко, А.Р. Каул, А.А. Босак, Д.И. Хомский, К.И. Кугель. Condmat/9805315.
- [8] A.S. Alexandrov, J. Ranninger. Phys. Rev. B23, 4, 1796 (1981).
- [9] Ю.А. Фирсов, Е.К. Кудинов. ФТТ **39**, *12*, 2159 (1997).
- [10] T. Holstein. Ann. of Phys. 8, 325 (1959).
- [11] T. Holstein. Ann. of Phys. 8, 343 (1959).
- [12] Е.К. Кудинов, Ю.А. Фирсов. ФТТ 7, 3, 546 (1965).
- [13] M. Born, Kun Huang. Dynamical Theory of Crystal Lattices. Clarendon Press, Oxford (1954). [М. Борн, Х. Кунь. Динамическая теория кристаллических решеток. ИИЛ, М. (1958). 488 с.].
- [14] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. ГИТТЛ, М. (1948). 568 с.
- [15] А.С. Александров. Письма ЖЭТФ 47, 12, 642 (1988).
- [16] И.Г. Ланг, Ю.А. Фирсов. ЖЭТФ 43, 1843 (1962).
- [17] А.В. Иванов, Е.К. Кудинов. ФТТ 31, 6, 14 (1989).
- [18] С.И. Пекар. Исследования по электронной теории кристаллов. ГТТИ, М. (1951).
- [19] A. Bill, V.Z. Kresin, S.A. Wolf. Cond-mat/9801222.
- [20] A.H. Romero, D.W. Brown, K. Lindenberg. Condmat/9710321.
- [21] A.H. Romero, D.W. Brow, K. Lindenberg. Cond-mat/9905174.
- [22] H.De Raedt, A. Lagendijk. Phys. Rev. B27, 10, 6097 (1983).
- [23] H.De Raedt, A. Lagendijk. Phys. Rev. B30, 4, 1671 (1984).
- [24] A.S. Alexandrov, V.V. Kabanov, D.K. Ray. Phys. Rev. 49, 14, 9915 (1994).
- [25] H. Fehske, H. Röder, G. Wellien, A. Mistriotis. Phys. Rev. B51, 16582 (1995).
- [26] G. Wellien, H. Fehske. Phys. Rev. B 56, 4513 (1997).